

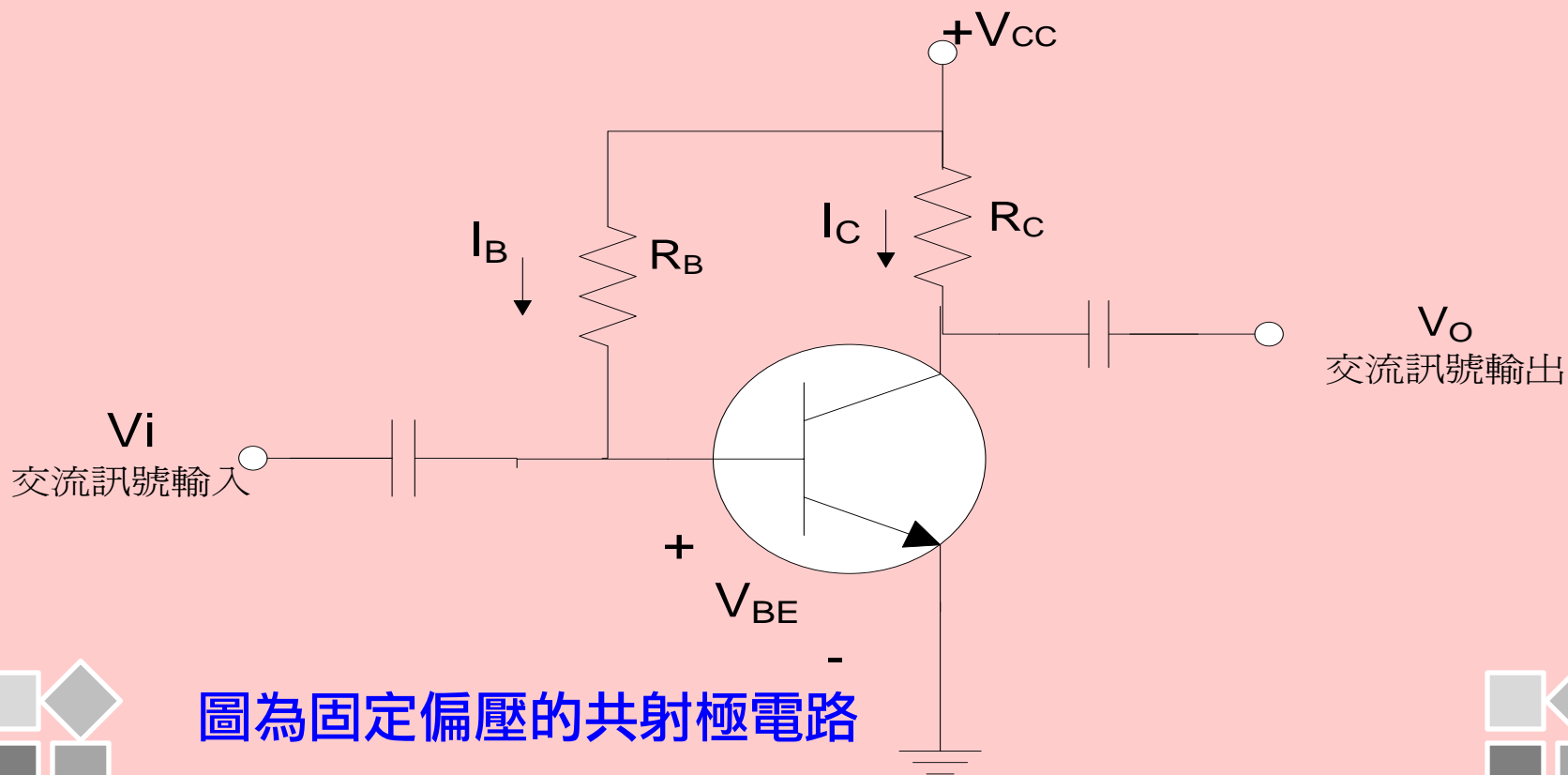
# 電晶體之直流偏壓

National Taiwan Normal University

講師：侯淇健

# 一、固定偏壓

## 固定偏壓電路分析

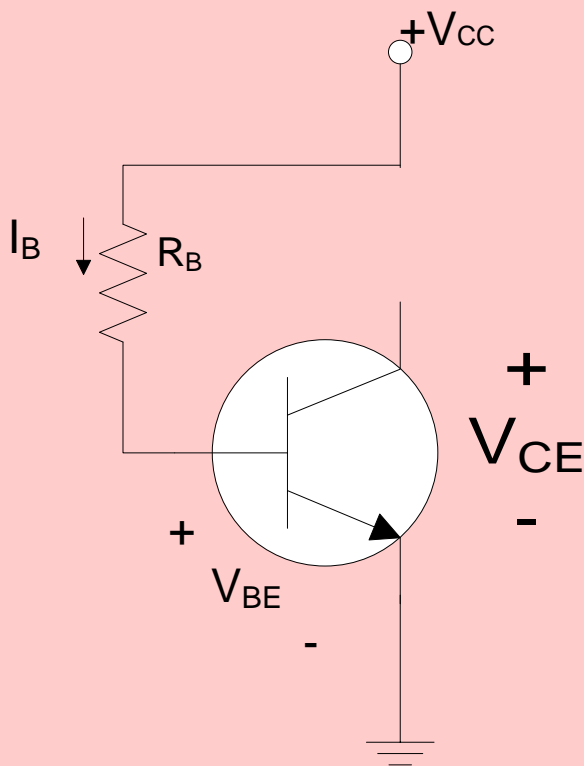


圖為固定偏壓的共射極電路

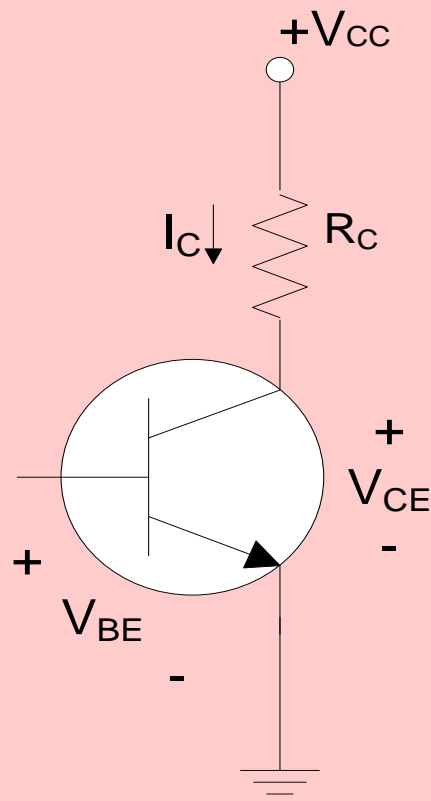
# 一、固定偏壓

## 直流偏壓分析

(左) 輸入迴路



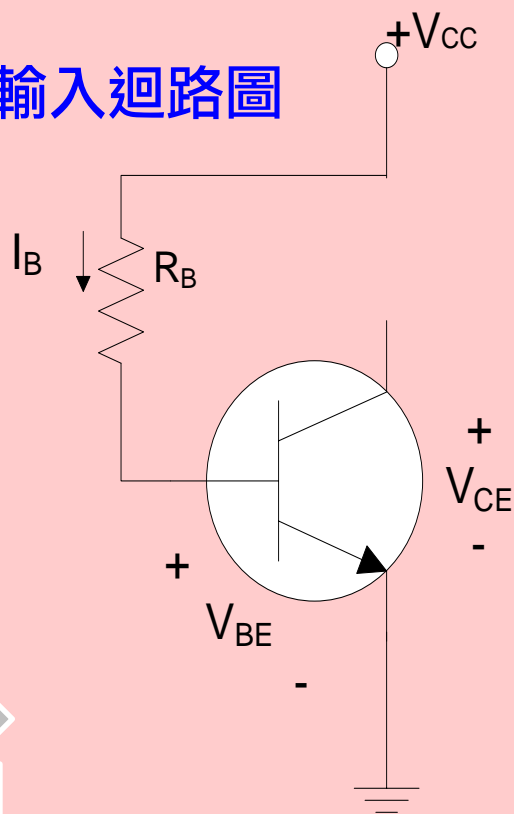
(右) 輸出迴路



# 一、固定偏壓

## 輸入迴路分析

輸入迴路圖



By KCL定律

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0 \Rightarrow I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

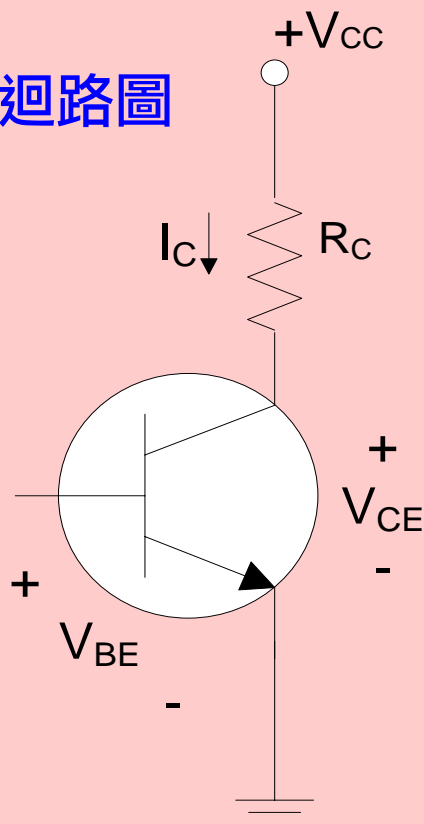
矽型 $V_{BE}=0.7V$ ，鍺型 $V_{BE}=0.3V$

$$\Rightarrow I_B \cong \frac{V_{CC}}{R_B}$$

# 一、固定偏壓

## 輸出迴路分析

輸出迴路圖



By KCL定律

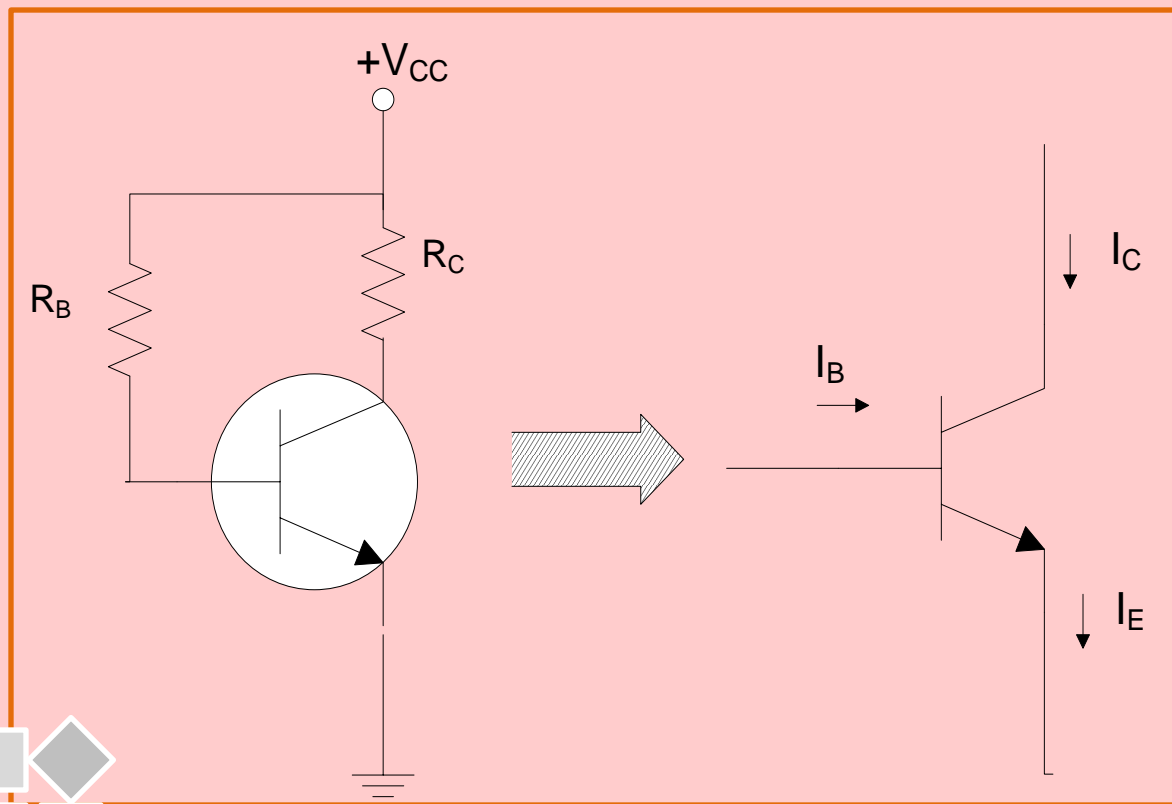
$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = \beta I_B$$

即可求出VCE

# 一、固定偏壓

## 線性放大狀態分析

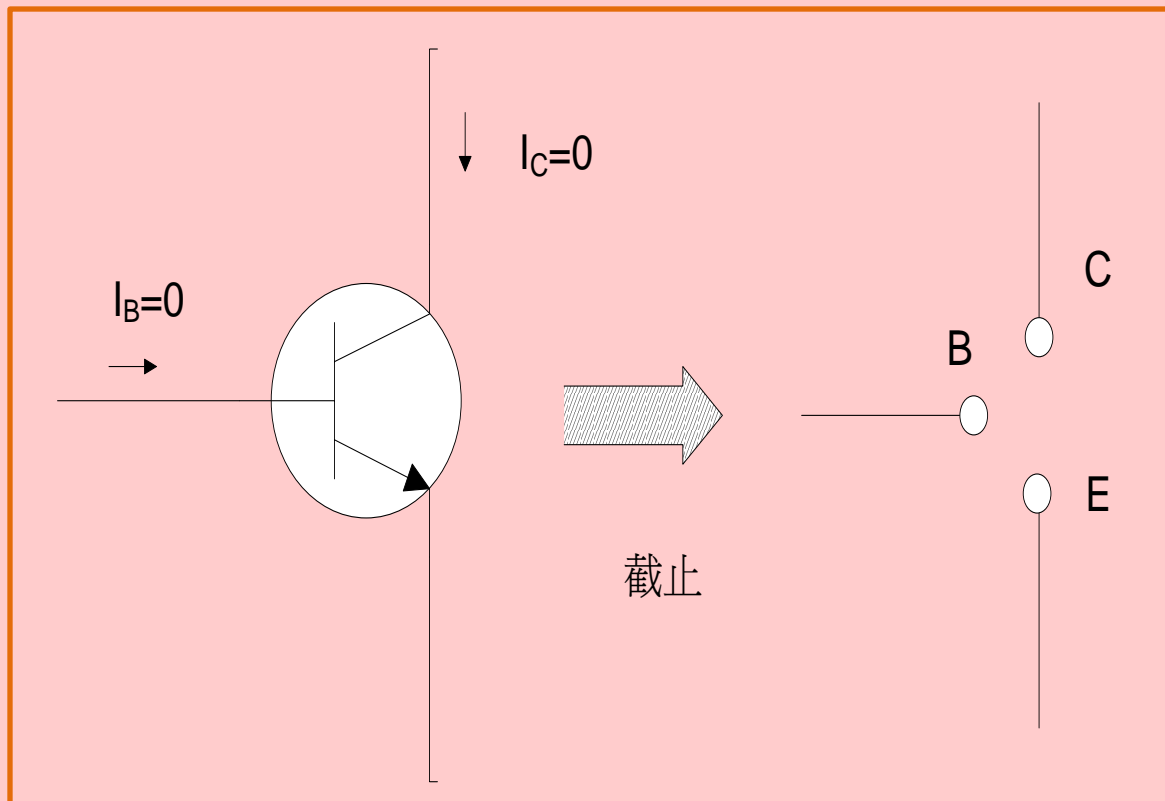


$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = (1 + \beta) I_B$$

# 一、固定偏壓

## 工作在截止區的分析

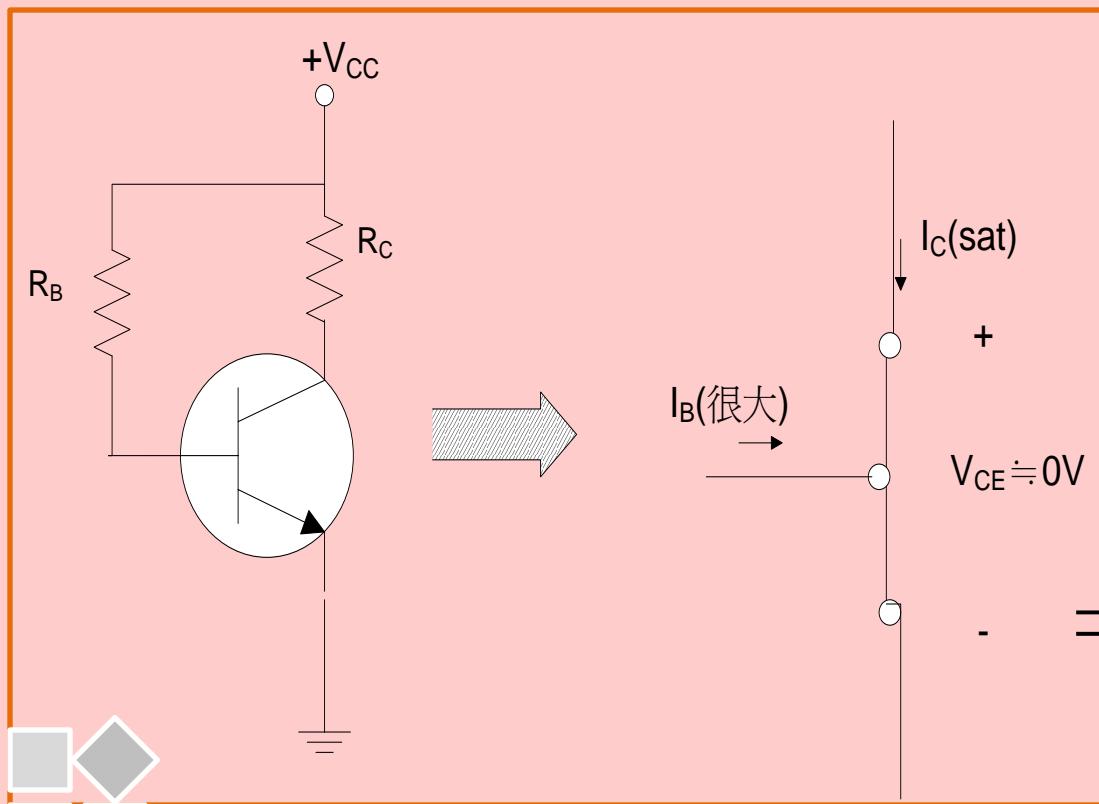


$$I_C = 0$$

$$I_B = 0$$

# 一、固定偏壓

## 工作在飽和區的分析



$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

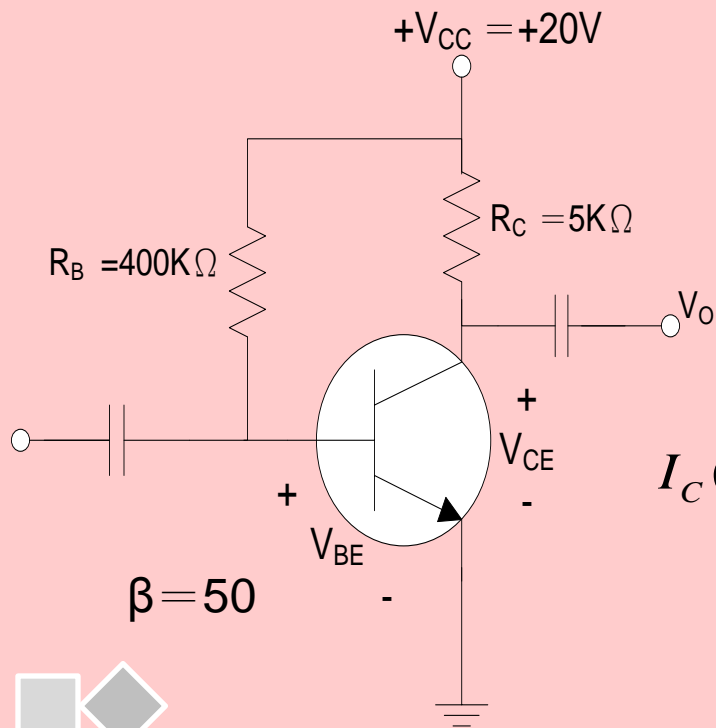
$$V_{CC} - I_C(sat) R_C = 0$$

$$\Rightarrow I_C(sat) \cong \frac{V_{CC}}{R_C}$$



# 一、固定偏壓

## 例題一：求 $I_B$ 與 $V_{CE}$ 電壓



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{20 - 0.7}{400k} \cong \frac{20}{400k} = 0.05mA$$

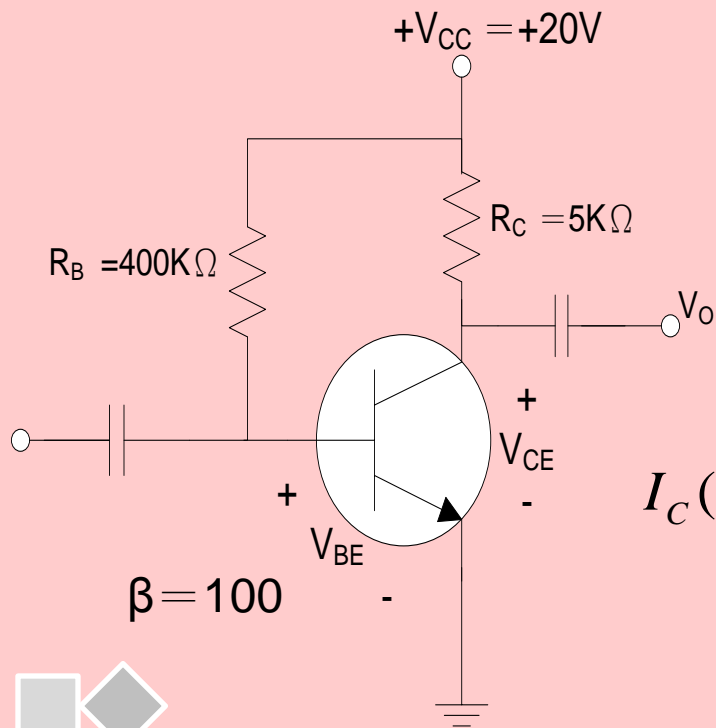
$$I_C = \beta I_B = 50 \times 0.05m = 2.5mA$$

$$I_C(sat) = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{20 - 0.2}{5k} \cong \frac{20}{5k} = 4mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20 - 2.5 \times 5k = 7.5V$$

# 一、固定偏壓

## 例題二：求 $I_B$ 與 $V_{CE}$ 電壓



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{20 - 0.7}{200k} \cong \frac{20}{200k} = 0.1mA$$

$$I_C = \beta I_B = 50 \times 0.1m = 5mA$$

$$I_C(sat) = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{20 - 0.2}{10k} \cong \frac{20}{10k} = 2mA$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(sat)R_C = 20 - 2m \times 10k = 0V$$

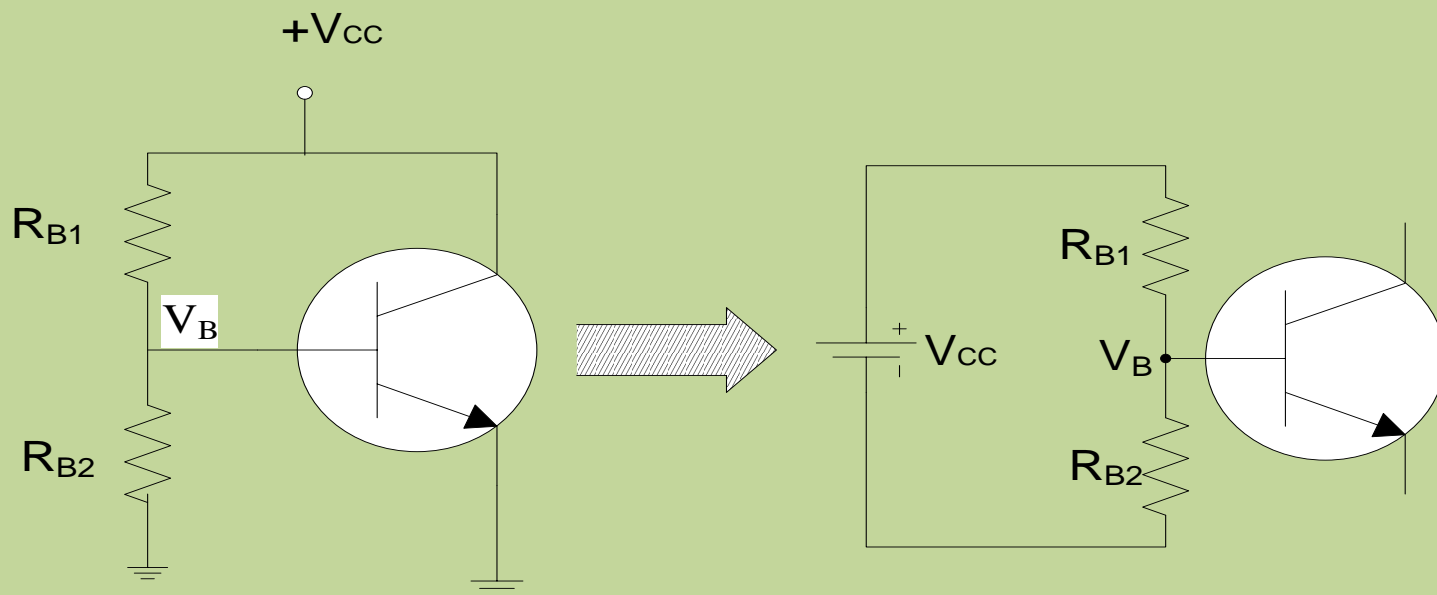
# 一、固定偏壓

## 固定偏壓與溫度間的關係

- $V_{BE}$ 
  - a. 矽 (Si) 型電晶體
    - 溫度每上升  $1^{\circ}\text{C}$  ,  $V_{BE}$  減少  $2.5\text{mV}$
  - b. 鍺 (Ge) 型電晶體
    - 溫度每上升  $1^{\circ}\text{C}$  ,  $V_{BE}$  減少  $1\text{mV}$
- $I_{CO}$ 
  - a. 矽 (Si) 型電晶體
    - 溫度每上升  $10^{\circ}\text{C}$  ,  $I_{CO}$  增加一倍
  - b. 鍺 (Ge) 型電晶體
    - 溫度每上升  $6^{\circ}\text{C}$  ,  $I_{CO}$  增加一倍
- $\beta$ 
  - 當溫度上升 ,  $\beta$  會增加

## 二、分壓偏壓

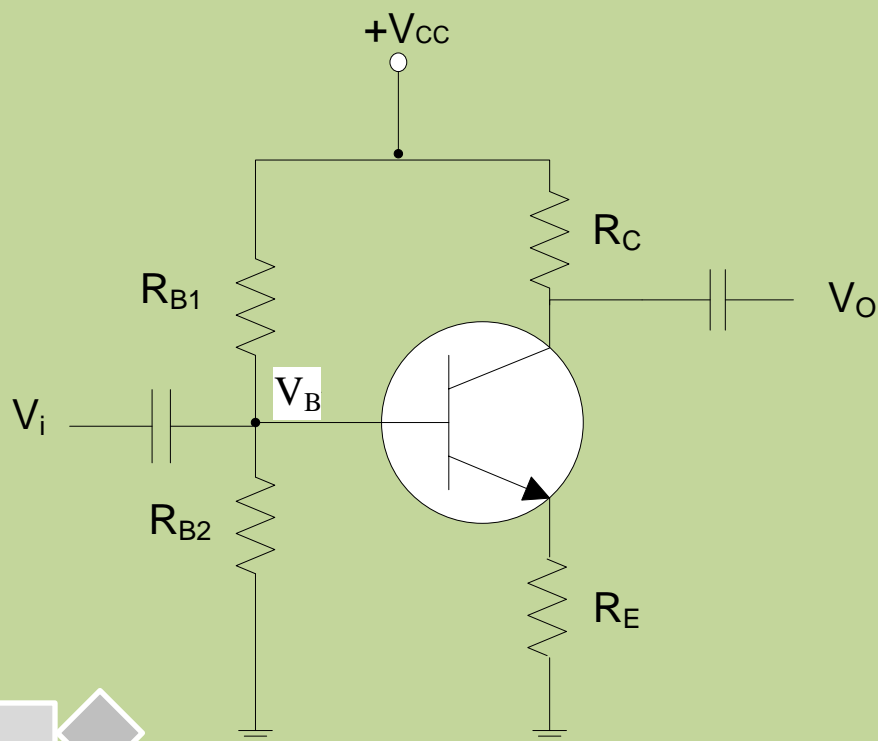
### 分壓偏壓電路說明



1.  $V_B$  是  $R_{B1}$  與  $R_{B2}$  分壓而來
2.  $V_B$  是電晶體的輸入電壓準位

## 二、分壓偏壓

### 近似法分析



分壓偏壓電路

$$I_{B1} \approx I_{B2} \square I_B$$

$$V_B = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

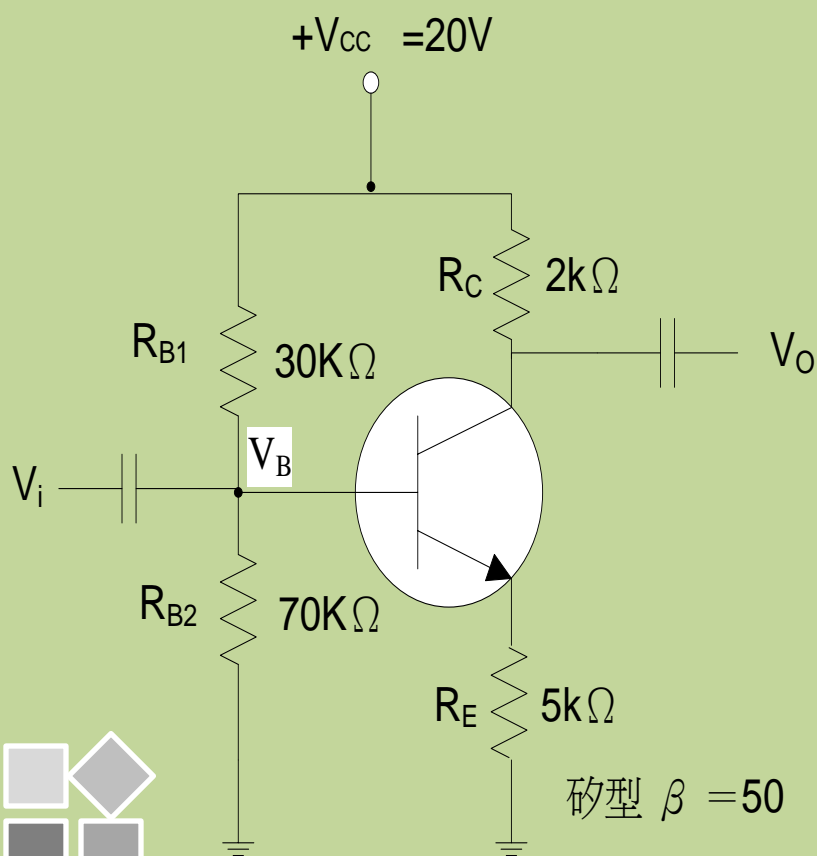
$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = (V_{CC} - I_C R_C) - (I_E R_E)$$

## 二、分壓偏壓

### 範例：求 $V_B$ 、 $I_C$ 、 $V_{CE}$ 值



$$(1) V_B = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \\ = 20 \times \frac{70k}{70k + 30k} = 14V$$

$$(2) V_E = V_B - V_{BE} = 14 - 0.7 = 13.3V$$

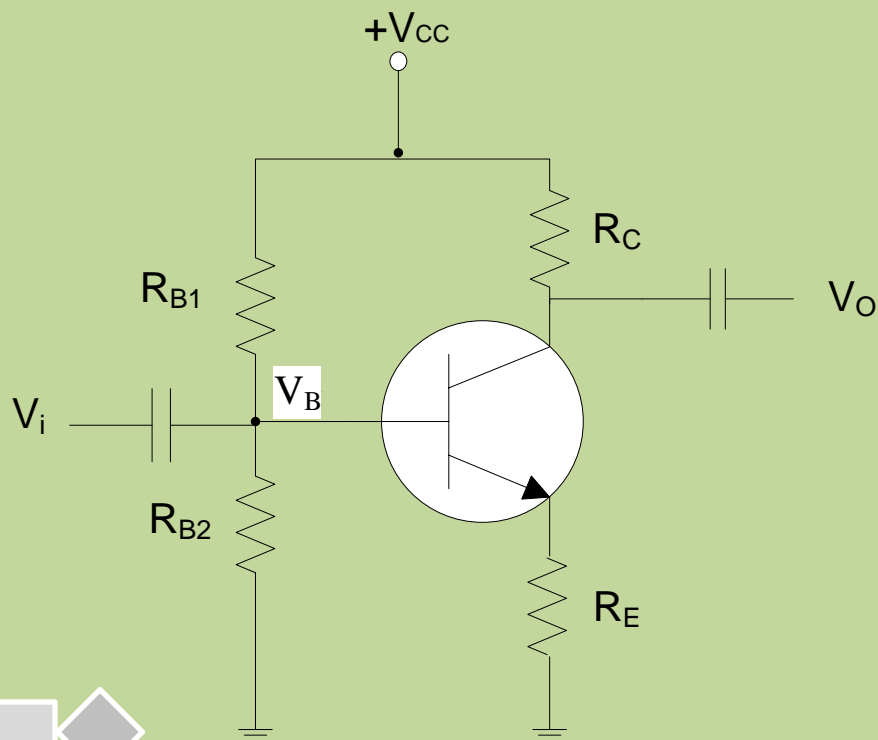
$$I_C = I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{13.3}{5} = 2.66mA$$

$$(3) V_{CE} = V_C - V_E = (V_{CC} - I_C R_C) - (I_E R_E) \\ = 20 - 2.66m \times 2k - 2.66m \times 5k \\ = 1.38V$$

## 二、分壓偏壓

### 精確法分析

$$I_{B1} \approx I_{B2} \square I_B$$



$$V_B = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

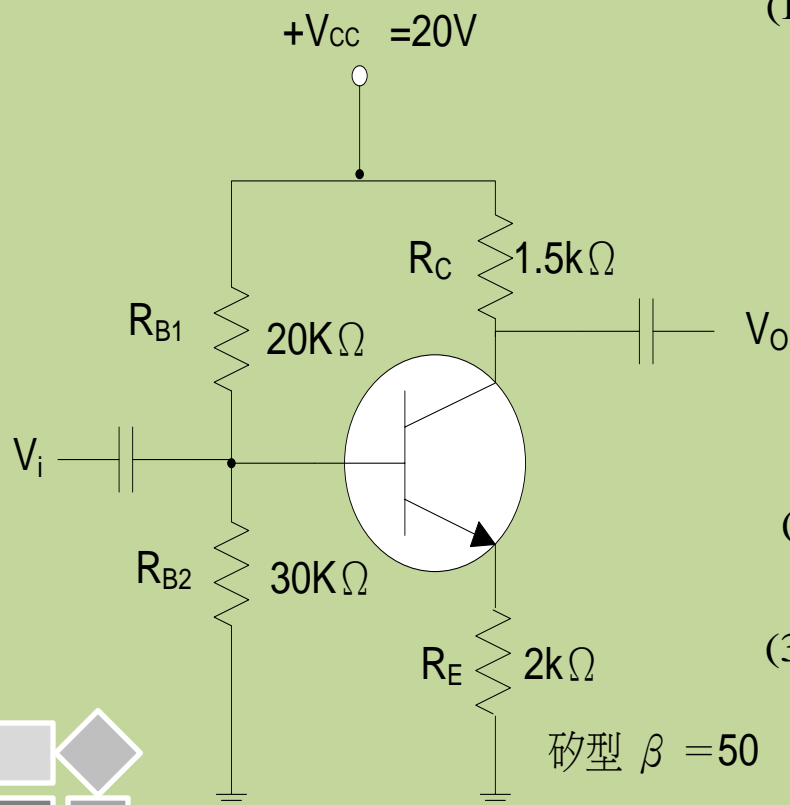
$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

利用戴維寧等效電路分析

$$V_{CE} = V_C - V_E = (V_{CC} - I_C R_C) - (I_E R_E)$$

## 二、分壓偏壓

### 範例：求 $V_B$ 、 $I_C$ 、 $V_{CE}$ 值



$$(1) R_{BB} = R_{B1} // R_{B2} = \frac{R_{B1} \times R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{20k \times 30k}{20k + 30k} = 12k$$

$$V_{BB} = V_{CC} \times \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 20 \times \frac{30k}{20k + 30k} = 12V$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB} + (1 + \beta)R_E} = \frac{12 - 0.7}{12k + (1 + 50)2k} = 0.1mA$$

$$(2) I_C = \beta I_B = 50 \times 0.1 = 5mA$$

$$\begin{aligned} (3) V_{CE} &= V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E \\ &= V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \\ &= 20 - 5m(1.5k + 2k) \\ &= 2.5V \end{aligned}$$